

Содержание

● Микро- и нанокристаллические, пористые, композитные полупроводники

Бессолов В.Н., Коненкова Е.В., Родин С.Н., Соломникова А.В., Шарофидинов Ш.Ш.

Исследование влияния наноструктурированных AlN/Si(100)-темплетов на рост полуполярных слоев AlN(1011) 3

Заводинский В.Г., Горкуша О.А., Орлов Е.Ю., Кузьменко А.П.

Электронные свойства фрагментов (колец) нанотрубок нитрида бора: моделирование методом теории функционала плотности 8

● Физика полупроводниковых приборов

Гавриленко В.И., Курицын Д.И., Антонов А.В., Ковалевский К.А., Жукавин Р.Х., Дюделев В.В., Черотченко Е.Д., Бабичев А.В., Лютецкий А.В., Слипченко С.О., Пихтин Н.А., Гладышев А.Г., Новиков И.И., Карачинский Л.Я., Егоров А.Ю., Соколовский Г.С.

Перестройка частоты излучения квантово-каскадного лазера среднего ИК диапазона 13

Лаврухина Е.А., Пашин Д.С., Нежданов А.В., Сидоренко К.В., Волков П.В., Бобров А.И.

Оптимизация параметров кремниевого электрооптического фазовращателя, работающего на эффекте обеднения свободными носителями 16

Бабичев А.В., Харин Н.Ю., Колодезный Е.С., Папылев Д.С., Вознюк Г.В., Митрофанов М.И., Гладышев А.Г., Слипченко С.О., Лютецкий А.В., Евтихий В.П., Паневин В.Ю., Карачинский Л.Я., Новиков И.И., Пихтин Н.А., Егоров А.Ю.

Одночастотные квантово-каскадные лазеры с переменной глубиной травления штрихов дифракционной решетки . . 23

Иго А.В., Вострецова Л.Н., Рибенек В.А.

Зависимость параметров спектра излучения InGaN/GaN-светодиода от величины инжекционного тока 29

Образцова А.А., Пивоварова А.А., Комаров С.Д., Федосов И.С., Иванов К.А., Калужный Н.А. Минтаилов С.А., Ильинская Н.Д., Яковлев Ю.П., Махов И.С., Крыжановская Н.В., Жуков А.Е.

Микродисковые лазеры с вынесенной контактной площадкой мостиковой конструкции, сформированные жидкостным химическим травлением 37

Афанасьев А.В., Забродский В.В., Ильин В.А., Серков А.В., Трушлякова В.В., Чигирев Д.А.

4H-SiC-фотодиоды с микронаноструктурированной поверхностью приемной области 43

Жидяев К.С., Чигинева А.Б., Байдусь Н.В., Самарцев И.В., Кудрин А.В.

Влияние уровня легирования эмиттерных областей на динамику включения низковольтных GaAs-динисторов . . 48

Aboimasov S.N., Levitskii V.S., Titov A.S., Terukov E.I.

On sputter damage of silicon heterojunction solar cells and its recovery by illuminated annealing 53